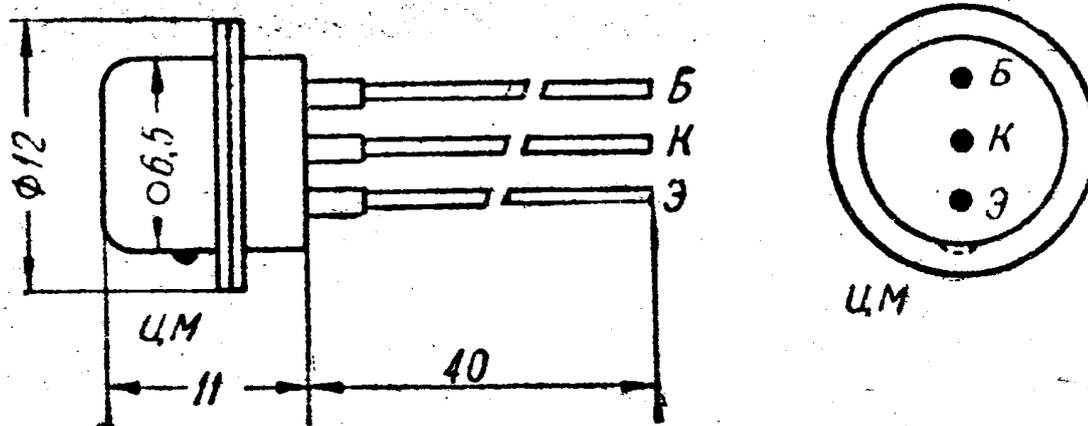


П501, П501А, П502, П502А, П502Б, П502В, П503, П503А

Транзисторы кремниевые диффузионные *n-p-n* высокочастотные маломощные.

Предназначены для усиления электрических сигналов (до 10 МГц П501, до 20 МГц П502, до 40 МГц П503) и генерирования электрических колебаний (до 10 МГц П501, до 30 МГц П502, до 60 МГц П503).

Выпускаются в металлическом герметичном корпусе со стеклянными изоляторами и гибкими выводами. Масса транзистора не более 2 г.



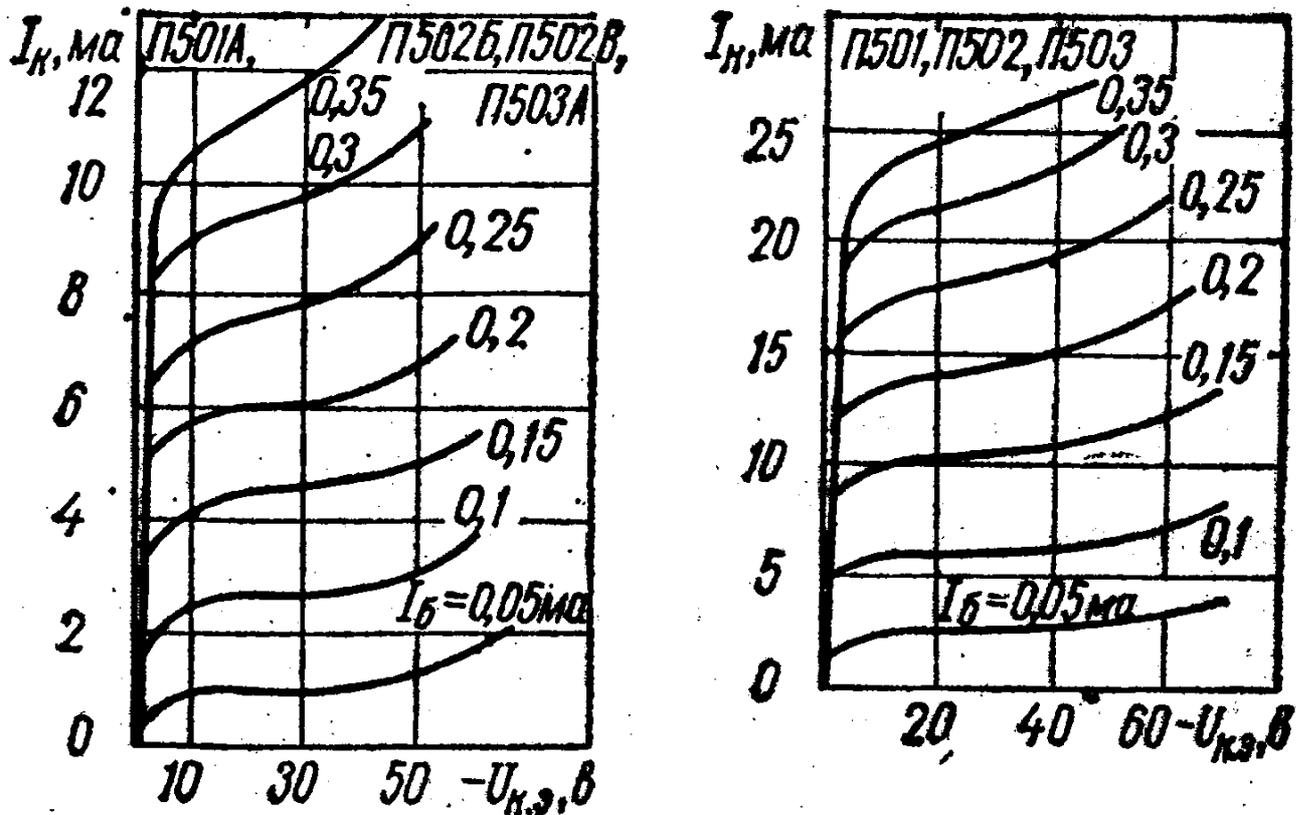
Электрические параметры

Коэффициент усиления по току в схеме с ОБ	
П501, П502, П502Б, П503	0,90
П501А, П502А, П502В, П503А	0,95
Коэффициент усиления по току в схеме с ОЭ	
на частоте 20 МГц	
П501, П501А	> 0,7
П502, П502А, П502Б, П502В	> 1
П503, П503А	> 1,5
на частоте 1000 Гц	
П501, П502, П502Б, П503, П503А	> 9
П501А, П502А, П502В	> 19
Обратный ток коллектора	
при $U_{кб} = 20 \text{ В}$ и $T = +20^\circ\text{C}$	< 50 мкА
при $U_{кб} = 20 \text{ В}$ и $T = +120^\circ\text{C}$	< 100 мкА
Обратный ток эмиттера при разомкнутом коллекторе	1 мкА
Емкость коллекторного перехода	10 пФ
Сопротивление насыщения	
П502	490 Ом
П502А	210 Ом
П502Б	230 Ом
П502В, П503, П503А	190 Ом
Выходная проводимость $h_{22Б}$	< 3 мкСм
Тепловое сопротивление переход-среда	0,6 °C/мВт

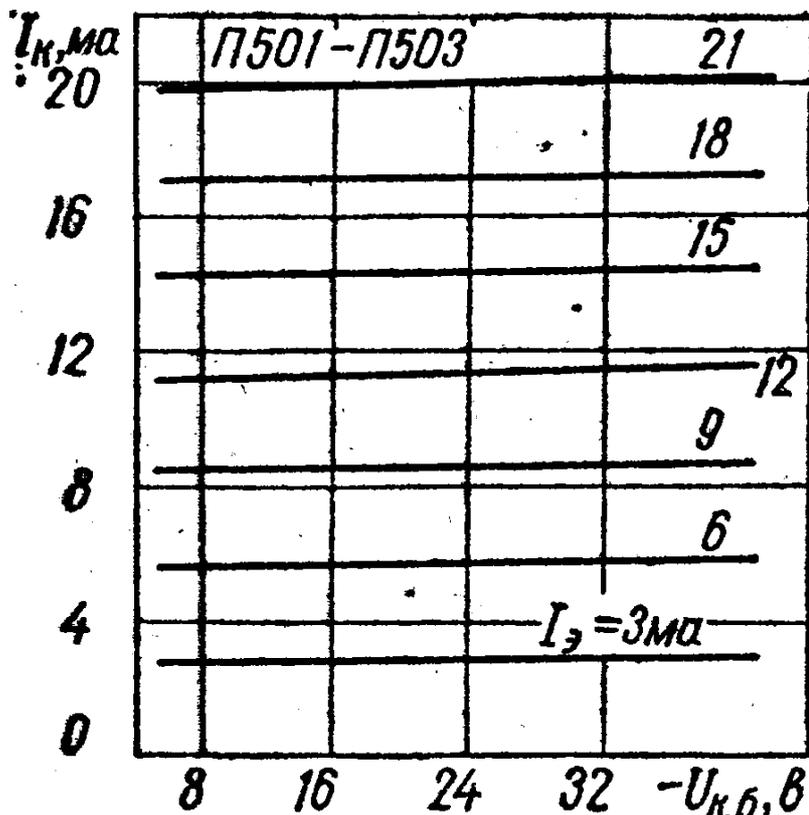
Предельные эксплуатационные данные

Напряжение коллектор-эмиттер при замкнутых эмиттере и базе	20 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	1 В
Напряжение коллектор-база при разомкнутом эмиттере	20 В
Ток коллектора	10 мА
Ток базы	10 мА
Рассеиваемая мощность	150 мВт
Температура окружающей среды	-60...+120° С
Наибольшая температура перехода	+150° С
Атмосферное давление	от 5 мм рт. ст. до 2 ати
Относительная влажность при +40°С	до 98%
Постоянные ускорения	до 150 g
Многokrратные удары	до 150 g
Наибольшее ускорение при вибрации	15 g

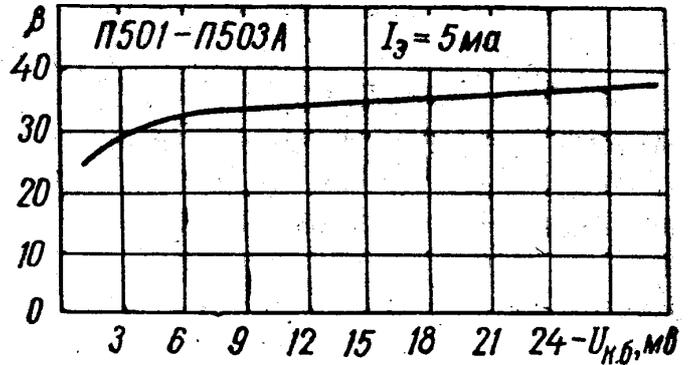
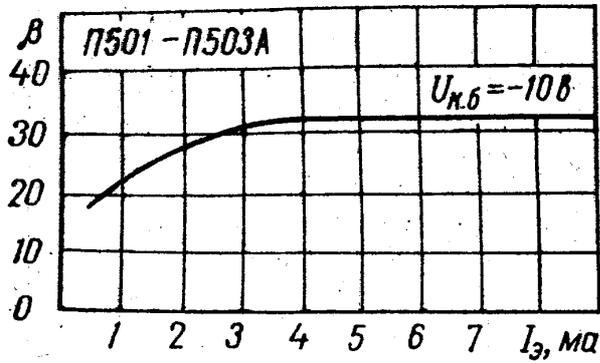
Выходные характеристики для схемы с общим эмиттером



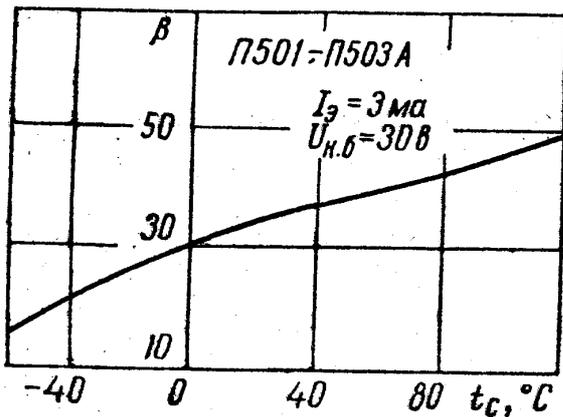
Выходные характеристики для схемы с общей базой



Зависимость коэффициента усиления
от тока эмиттера от напряжения на коллекторе



Зависимость коэффициента усиления
от температуры



Зависимость наибольшей частоты генерации
от тока эмиттера

